

【公報種別】商標公報の訂正

【発行日】令和6年9月5日（2024. 9. 5）

【登録番号】商標登録第6834319号（T6834319）

【掲載公報発行日】令和6年8月23日（2024. 8. 23）

【年通号数】登録公報（商標）2024-158

【区分】9

【出願番号】商願2023-129939（T2023-129939）

【訂正要旨】【商標権者】の【住所又は居所】に誤り，【住所又は居所原語表記】の誤載により以下のとおり訂正する。

（190）【発行国】日本国特許庁（JP）

（450）【発行日】令和6年8月23日（2024. 8. 23）

【公報種別】商標公報

（111）【登録番号】商標登録第6834319号（T6834319）

（151）【登録日】令和6年8月15日（2024. 8. 15）

（540）【登録商標】

Longforce

（500）【商品及び役務の区分の数】1

（511）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第9類 セキュリティ機能をサポートするオペレーティングシステムプログラム用の記録されたメモリコントローラーファームウェア（すなわち、ユニークデバイス識別子、セキュアブートモード、NANDアクセスモード制御、動的に調整可能なドライブ容量、セキュア消去機能、ライトプロテクション、暗号化機能付きのもの）、セキュリティ機能をサポートするオペレーティングシステムプログラム用のファームウェアが記録されたメモリモジュール（ユニークデバイス識別子、セキュアブートモード、NANDアクセスモード制御、動的に調整可能なドライブ容量、セキュア消去機能、ライトプロテクション、暗号化機能付きのもの）、耐久性と信頼性の機能を備えたダイナミックランダムアクセスメモリデバイスで構成されたメモリモジュール（サーマルスロットリング、産業用温度範囲コンポーネント、コンフォーマルコーティング、硫黄対策抵抗器、アンダーフィル、およびリテンションクリップ付きのもの）、メモリーモジュール、即ちDRAM搭載、フラッシュ搭載又はDRAM及びフラッシュ搭載のデュアルインラインメモリーモジュール（DIMM）、集積回路、半導体チップ、サーマルスロットリング、擬似SLCサポート、ウェアレベリング、ガベージコレクション（GC）、TRIMコマンドサポート、及びオーバープロビジョニング（OP）などの耐久性機能を有するフラッシュメモリデバイスを搭載したメモリーモジュール、メモリーモジュール、すなわちフラッシュベースのソリッドステートドライブ（SSD）、取り外し可能なフラッシュドライブ、及びフラッシュメモリカード、メモリーモジュール、メモリー拡張モジュール、集積回路モジュール

【国際分類第12版】

（210）【出願番号】商願2023-129939（T2023-129939）

（220）【出願日】令和5年11月22日（2023. 11. 22）

（732）【商標権者】

【識別番号】518415060

【氏名又は名称】深▲せん▼市江波龍電子股▲ふん▼有限公司

【氏名又は名称原語表記】Shenzhen longsys electronics Co., Ltd.

【住所又は居所】中華人民共和国広東省深▲せん▼市前海深港協力区南山街道聽海大道5059号鴻榮源前海金融センター二期B座2001、2201、2301

(740) 【代理人】

【識別番号】 1 1 0 0 0 7 9 6

【氏名又は名称】 弁理士法人三枝国際特許事務所

【法区分】 平成 2 3 年改正

【審査官】 菅沼 結香子

(561) 【称呼 (参考情報)】 ロングフォース、ロング、フォース

【検索用文字商標 (参考情報)】 LONGFORCE

【類似群コード (参考情報)】

第 9 類 1 1 C 0 1